

## МДТКИ-800-17Т

**IGBT  
модули**

[www.elvpr.ru](http://www.elvpr.ru)

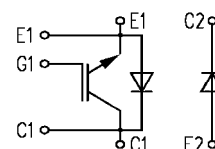
### СИЛОВОЙ IGBT МОДУЛЬ

- ◆ одиночный ключ с диодом чоппера (диод может быть подключен как со стороны эмиттера, так и со стороны коллектора с помощью внешних силовых шин)
- ◆ встроенный быстродействующий диод обратного тока
- ◆ повышенная устойчивость к температурным циклам (не менее 100 000 циклов при  $\Delta T_j = 70 \text{ }^\circ\text{C}$ )
- ◆ корпус повышенной прочности с изолированным основанием из композиционного материала (AlSiC)
- ◆ специальные металлокерамические платы на основе AlN
- ◆ специальная защита сварных соединений
- ◆ уменьшенные статические и динамические потери
- ◆ соответствие международным стандартам по габаритным и присоединительным размерам



### ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- ◆ транспорт
- ◆ мощные высоковольтные электропривода, работающие в циклическом режиме



### ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

- ◆  $V_{CES} = \underline{1700 \text{ В}}$
- ◆  $I_C = \underline{1600 \text{ А}}$  ( $T_C = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ )
- ◆  $V_{CEsat} = \underline{2.6 \text{ В}}$  (тип.)
- ◆  $I_C = \underline{800 \text{ А}}$  ( $T_C = 80 \text{ }^\circ\text{C}$ )

### МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

Наименование параметра	Условное обозначение	Значение параметра	Единица измерения
Напряжение коллектор-эмиттер	$V_{CE}$	1700	В
Напряжение затвор-эмиттер	$V_{GE}$	$\pm 20$	
Постоянный ток коллектора	$I_C$	при $T_C = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	1600
		при $T_C = 80 \text{ }^\circ\text{C}$	800
Импульсный ток коллектора ( $t_p=1 \text{ мс}$ , $T_C = 80 \text{ }^\circ\text{C}$ )	$I_{Cpuls}$	1600	А
Постоянный прямой ток, диод обратного тока / диод чоппера	$I_F / I_{FC}$	800	
Повторяющийся импульсный прямой ток, диод обратного тока / диод чоппера	$I_{FRM} / I_{FRMC}$	1600	
Параметр $I^2t$ , диод обратного тока / диод чоппера ( $t_p = 10 \text{ мс}$ , $T_j = 125 \text{ }^\circ\text{C}$ )	$I^2t / I^2t_C$	240	$\text{кА}^2\text{с}$
Суммарная мощность рассеивания ( $T_C = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ ), IGBT	$P_{tot}$	6250	Вт
Максимальная температура перехода	$T_j$	+ 150	$^\circ\text{C}$

## МДТКИ-800-17Т

Температура хранения	$T_{stg}$	- 50...+ 125	
Напряжение изоляции (t = 1 мин.)	$V_{isol}$	4000	В (эфф)

### ТЕПЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование параметра	Условное обозначение	Значение параметра	Единица измерения
Тепловое сопротивление переход-корпус, IGBT	$R_{thjc}$	$\leq 0.020$	°C/Вт
Тепловое сопротивление переход-корпус, диод обратного тока / диод чоппера	$R_{thjcD} / R_{thjcDC}$	$\leq 0.034$	
Тепловое сопротивление корпус-охладитель, $\lambda_{paste} = 1$ Вт/м · °C, на модуль (типичное значение)	$R_{thck}$	0.008	

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (при 25 °C, если не указано иное значение)

Наименование параметра	Условное обозначение	Значение параметра			Единица измерения
		мин.	тип.	макс.	

#### Статические характеристики

Пороговое напряжение затвор-эмиттер ( $V_{GE} = V_{CE}, I_C = 65$ мА)	$V_{GE(th)}$	4.5	5.5	6.5	В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер ( $V_{GE} = 15$ В, $I_C = 800$ А) при $T_j = 25$ °C при $T_j = 125$ °C	$V_{CEsat}$	- -	2.6 3.1	3.1 3.6	
Ток утечки коллектор-эмиттер ( $V_{CE} = 1700$ В, $V_{GE} = 0$ В) при $T_j = 25$ °C при $T_j = 125$ °C	$I_{CES}$	- -	0.02 10	1.5 80	мА
Ток утечки затвор-эмиттер ( $V_{GE} = 20$ В, $V_{CE} = 0$ В)	$I_{GES}$	-	-	400	нА

#### Характеристики на переменном токе

Входная емкость ( $V_{CE} = 25$ В, $V_{GE} = 0$ В, $f = 1$ МГц)	$C_{ies}$	-	52	-	нФ
Обратная переходная емкость ( $V_{CE} = 25$ В, $V_{GE} = 0$ В, $f = 1$ МГц)	$C_{res}$	-	2.7	-	

#### Характеристики переключения (индуктивная нагрузка, при $T_j = 125$ °C)

Время задержки включения ( $V_{CC} = 900$ В, $V_{GE} = \pm 15$ В, $I_C = 800$ А, $R_G = 1.2$ Ом) при $T_j = 25$ °C при $T_j = 125$ °C	$t_{d(on)}$	- -	0.4 0.4	- -	мкс
Время нарастания ( $V_{CC} = 900$ В, $V_{GE} = \pm 15$ В, $I_C = 800$ А, $R_G = 1.2$ Ом) при $T_j = 25$ °C при $T_j = 125$ °C	$t_r$	- -	0.14 0.14	- -	



## МДТКИ-800-17Т

Время задержки выключения ( $V_{CC} = 900 \text{ В}$ , $V_{GE} = \pm 15 \text{ В}$ , $I_C = 800 \text{ А}$ , $R_G = 1.8 \text{ Ом}$ ) при $T_j = 25 \text{ °C}$ при $T_j = 125 \text{ °C}$	$t_{d(off)}$	- -	1.1 1.1	- -	мкс
Время спада ( $V_{CC} = 900 \text{ В}$ , $V_{GE} = \pm 15 \text{ В}$ , $I_C = 800 \text{ А}$ , $R_G = 1.8 \text{ Ом}$ ) при $T_j = 25 \text{ °C}$ при $T_j = 125 \text{ °C}$	$t_f$	- -	0.13 0.14	- -	
Энергия потерь при включении ( $V_{CC} = 900 \text{ В}$ , $V_{GE} = \pm 15 \text{ В}$ , $I_C = 800 \text{ А}$ , $R_G = 1.2 \text{ Ом}$ , $T_j = 125 \text{ °C}$ , $L_S = 50 \text{ нГн}$ , за один импульс)	$E_{on}$	-	290	-	мДж
Энергия потерь при выключении ( $V_{CC} = 900 \text{ В}$ , $V_{GE} = \pm 15 \text{ В}$ , $I_C = 800 \text{ А}$ , $R_G = 1.8 \text{ Ом}$ , $T_j = 125 \text{ °C}$ , $L_S = 50 \text{ нГн}$ , за один импульс)	$E_{off}$	-	335	-	
Ток короткого замыкания ( $t_p \leq 10 \text{ мкс}$ , $V_{CC} = 1000 \text{ В}$ , $V_{GE} = \pm 15 \text{ В}$ , $V_{CEmax} = V_{CES} - L_{\sigma(CE)} \times di/dt$ , $T_j = 125 \text{ °C}$ )	$I_{SC}$	-	3200	-	А
Внутренняя индуктивность модуля по цепи коллектор-эмиттер	$L_{\sigma(CE)}$	-	20	-	нГн

## Характеристики диода обратного тока

Прямое падение напряжения ( $I_F = 800 \text{ А}$ , $V_{GE} = 0 \text{ В}$ ) при $T_j = 25 \text{ °C}$ при $T_j = 125 \text{ °C}$	$V_F$	- -	2.1 2.1	2.5 2.5	В
Ток обратного восстановления ( $I_F = 800 \text{ А}$ , $V_{GE} = -10 \text{ В}$ , $V_R = 900 \text{ В}$ , $di_F/dt = -6300 \text{ А/мкс}$ ) при $T_j = 25 \text{ °C}$ при $T_j = 125 \text{ °C}$	$I_{rr}$	- -	800 900	- -	А
Время обратного восстановления ( $I_F = 800 \text{ А}$ , $V_{GE} = -10 \text{ В}$ , $V_R = 900 \text{ В}$ , $di_F/dt = -6300 \text{ А/мкс}$ , $T_j = 125 \text{ °C}$ )	$t_{rr}$	-	0.69	-	мкс
Заряд обратного восстановления ( $I_F = 800 \text{ А}$ , $V_{GE} = -10 \text{ В}$ , $V_R = 900 \text{ В}$ , $di_F/dt = -6300 \text{ А/мкс}$ ) при $T_j = 25 \text{ °C}$ при $T_j = 125 \text{ °C}$	$Q_{rr}$	- -	170 310	- -	мкКл
Энергия потерь при обратном восстановлении ( $I_F = 800 \text{ А}$ , $V_{GE} = -10 \text{ В}$ , $V_R = 900 \text{ В}$ , $di_F/dt = -6300 \text{ А/мкс}$ ) при $T_j = 25 \text{ °C}$ при $T_j = 125 \text{ °C}$	$E_{rec}$	- -	80 170	- -	мДж

## МДТКИ-800-17Т

### Характеристики диода чоппера

Прямое падение напряжения ( $I_F = 800 \text{ A}$ , $V_{GE} = 0 \text{ B}$ ) при $T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ при $T_j = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	$V_{FC}$	- -	2.1 2.1	2.5 2.5	В
Время обратного восстановления ( $I_F = 800 \text{ A}$ , $V_{GE} = -10 \text{ B}$ , $V_R = 900 \text{ B}$ , $di_F/dt = -6300 \text{ A/мкс}$ , $T_j = 125 \text{ }^\circ\text{C}$ )	$t_{rrc}$	-	0.69	-	мкс
Ток обратного восстановления ( $I_F = 800 \text{ A}$ , $V_{GE} = -10 \text{ B}$ , $V_R = 900 \text{ B}$ , $di_F/dt = -6300 \text{ A/мкс}$ ) при $T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ при $T_j = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	$I_{rrc}$	- -	480 680	- -	А
Заряд обратного восстановления ( $I_F = 800 \text{ A}$ , $V_{GE} = -10 \text{ B}$ , $V_R = 900 \text{ B}$ , $di_F/dt = -6300 \text{ A/мкс}$ ) при $T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ при $T_j = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	$Q_{rrc}$	- -	170 310	- -	мкКл
Энергия потерь при обратном восстановлении ( $I_F = 800 \text{ A}$ , $V_{GE} = -10 \text{ B}$ , $V_R = 900 \text{ B}$ , $di_F/dt = -6300 \text{ A/мкс}$ ) при $T_j = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ при $T_j = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	$E_{recC}$	- -	80 170	- -	мДж

### ПРОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование параметра	Категория, группа	Документ
Устойчивость к механическим воздействиям	М25	ГОСТ 17516.1 ГОСТ 20859.1
Климатическое исполнение	УХЛ2.1	ГОСТ 15150 ГОСТ 15543

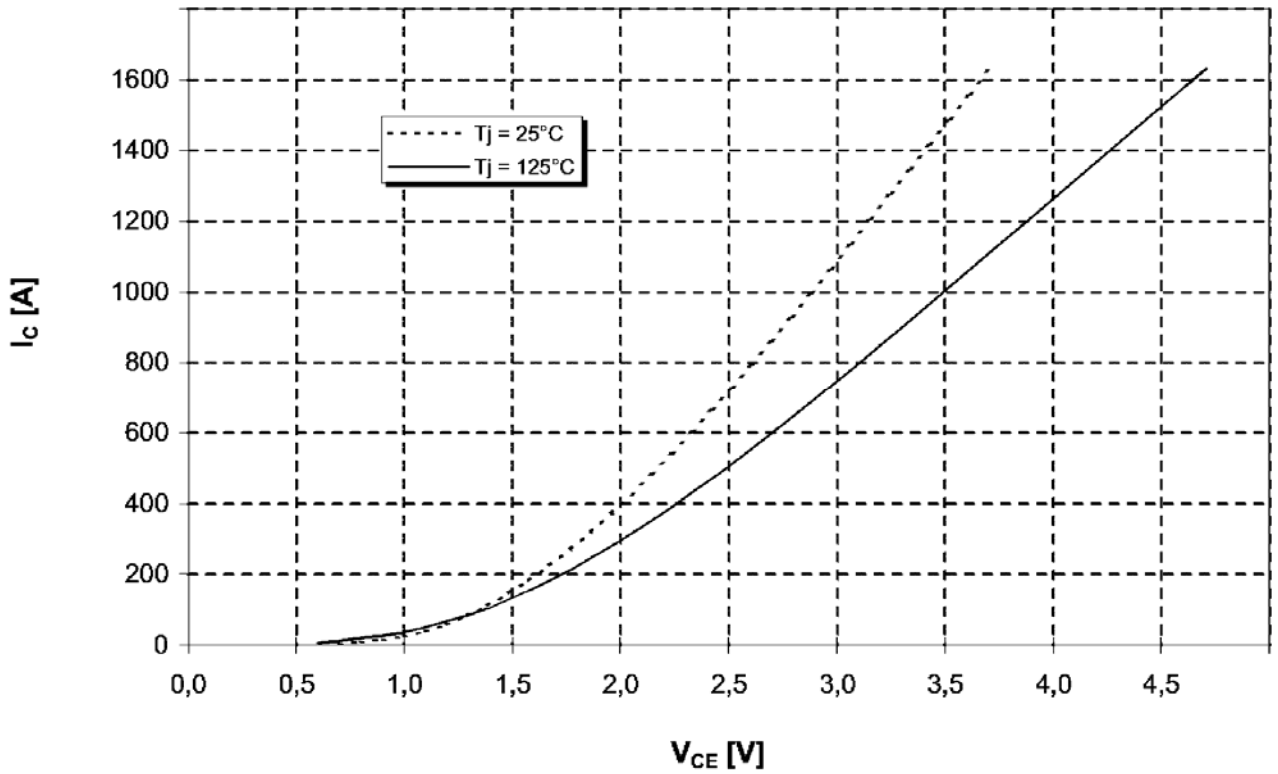


# МДТКИ-800-17Т

Типовые выходные характеристики

$$I_C = f(V_{CE})$$

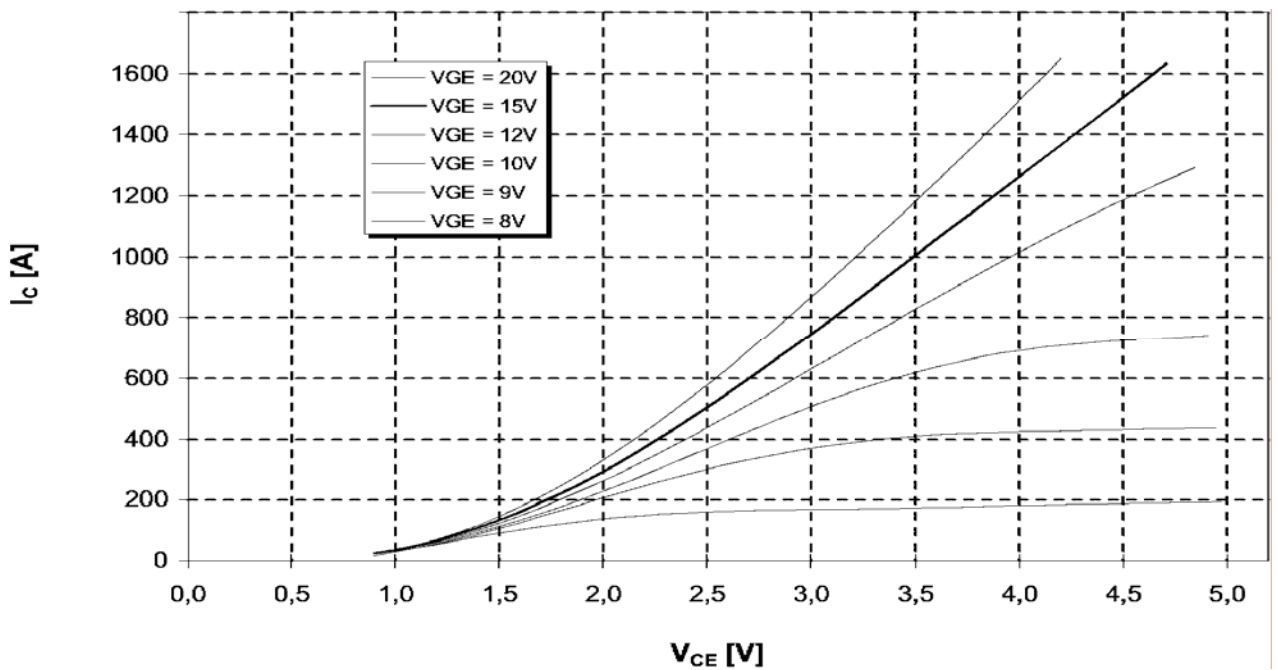
Режим измерения:  $V_{GE} = +15$  В,  $T_j = 25, 125$  °С



Типовые выходные характеристики

$$I_C = f(V_{CE})$$

Режим измерения:  $T_j = 125$  °С



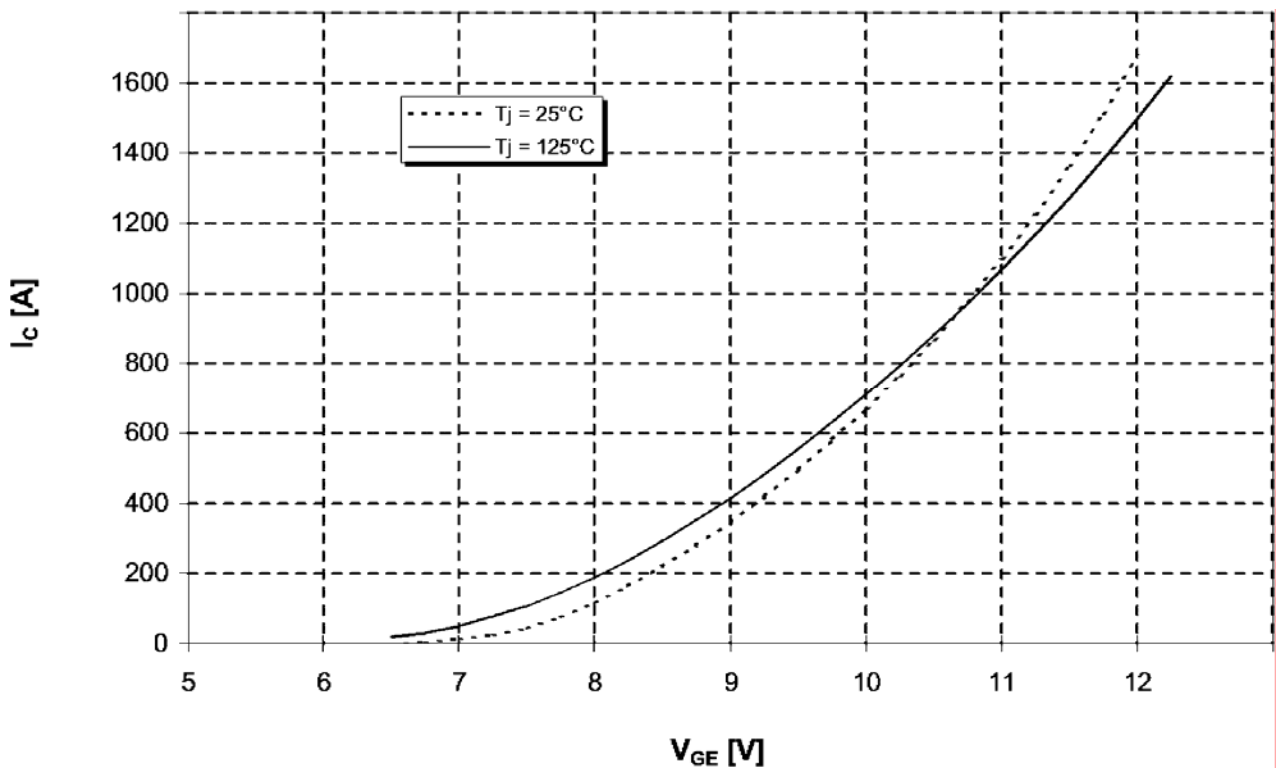


# МДТКИ-800-17Т

Типовые передаточные характеристики

$$I_C = f(V_{GE})$$

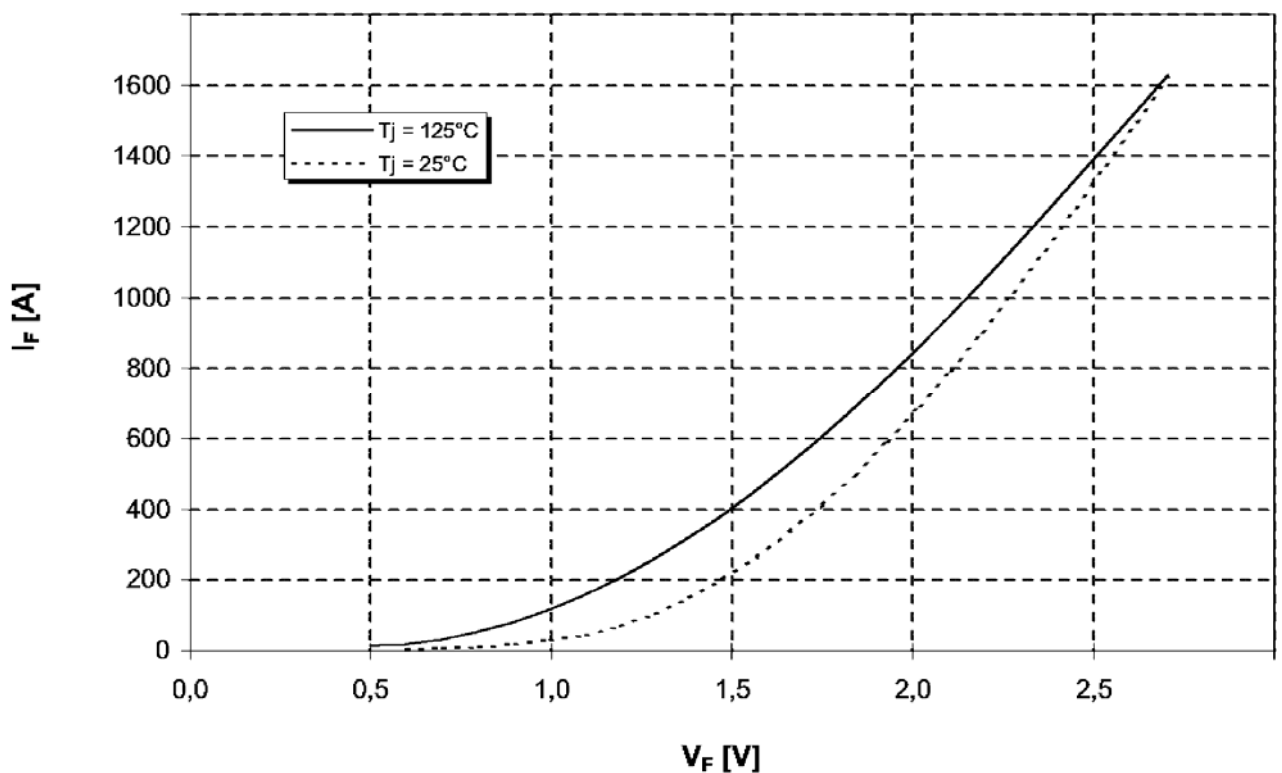
Режим измерения:  $V_{CE} = 20 \text{ В}$ ,  $T_j = 25, 125 \text{ }^\circ\text{C}$



Типовые прямые характеристики диода обратного тока

$$I_F = f(V_F)$$

Режим измерения:  $T_j = 25, 125 \text{ }^\circ\text{C}$



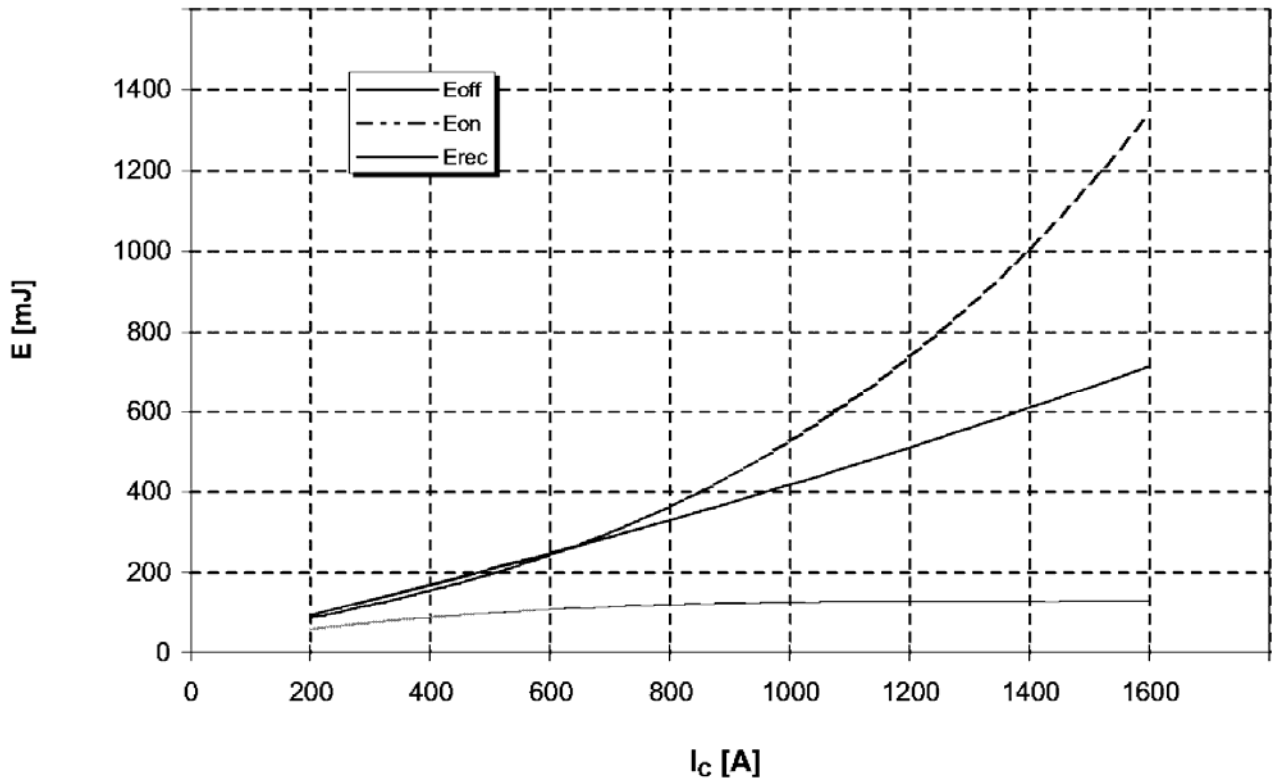


# МДТКИ-800-17Т

Типовые зависимости коммутационных потерь

$E = f(I_C)$ , индуктивная нагрузка

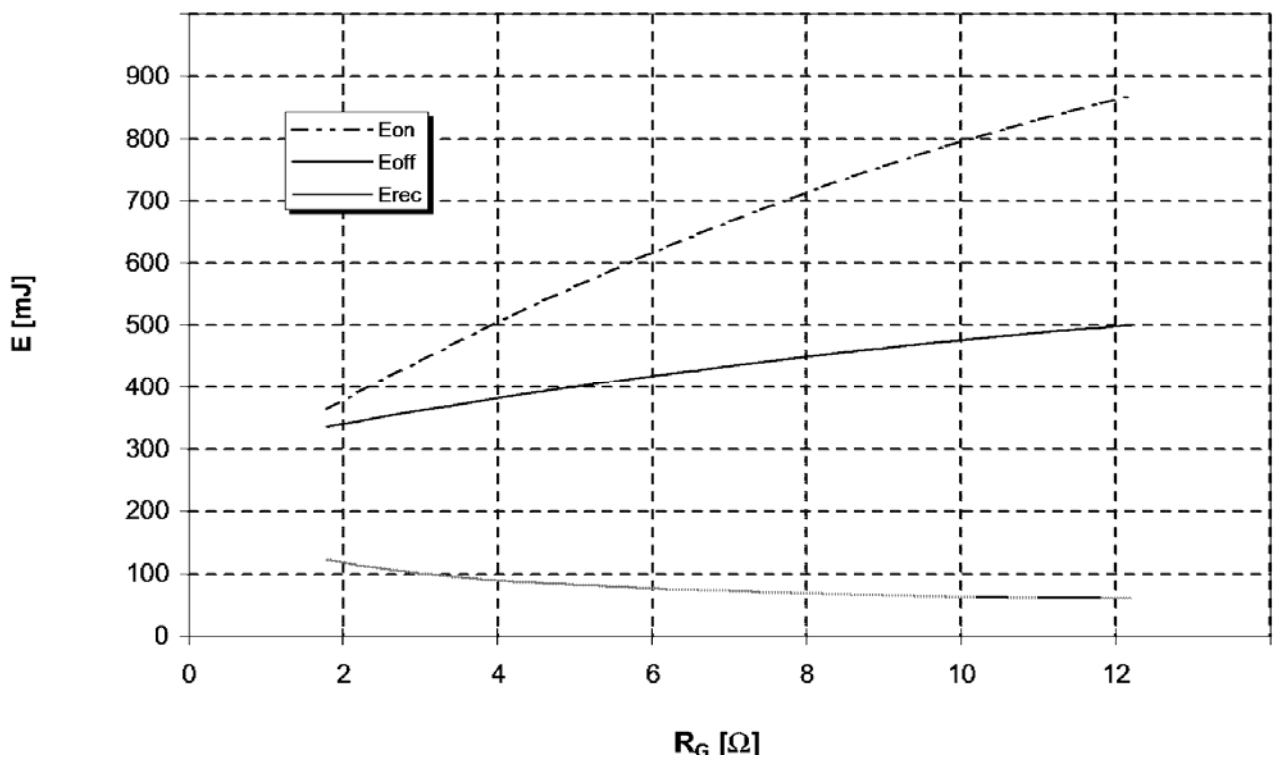
Режим измерения:  $V_{CE} = 900$  В,  $V_{GE} = \pm 15$  В,  $R_G = 1.8$  Ом,  $T_j = 125$  °С



Типовые зависимости коммутационных потерь

$E = f(R_G)$ , индуктивная нагрузка

Режим измерения:  $I_C = 800$  А,  $V_{CE} = 900$  В,  $V_{GE} = \pm 15$  В,  $T_j = 125$  °С

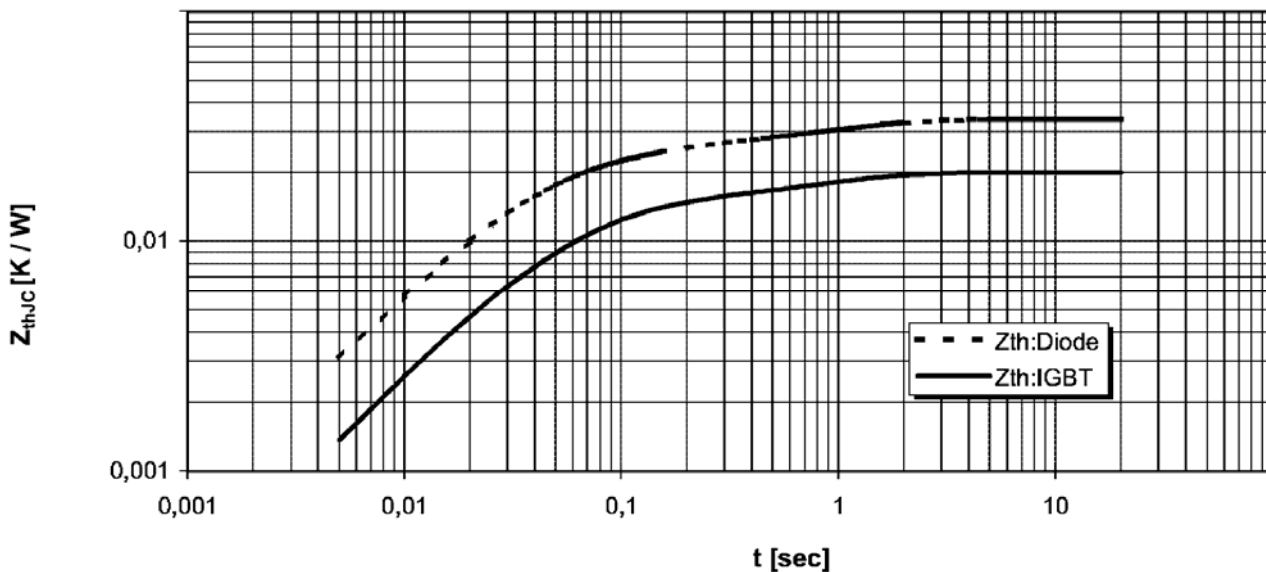




# МДТКИ-800-17Т

Переходное тепловое сопротивление

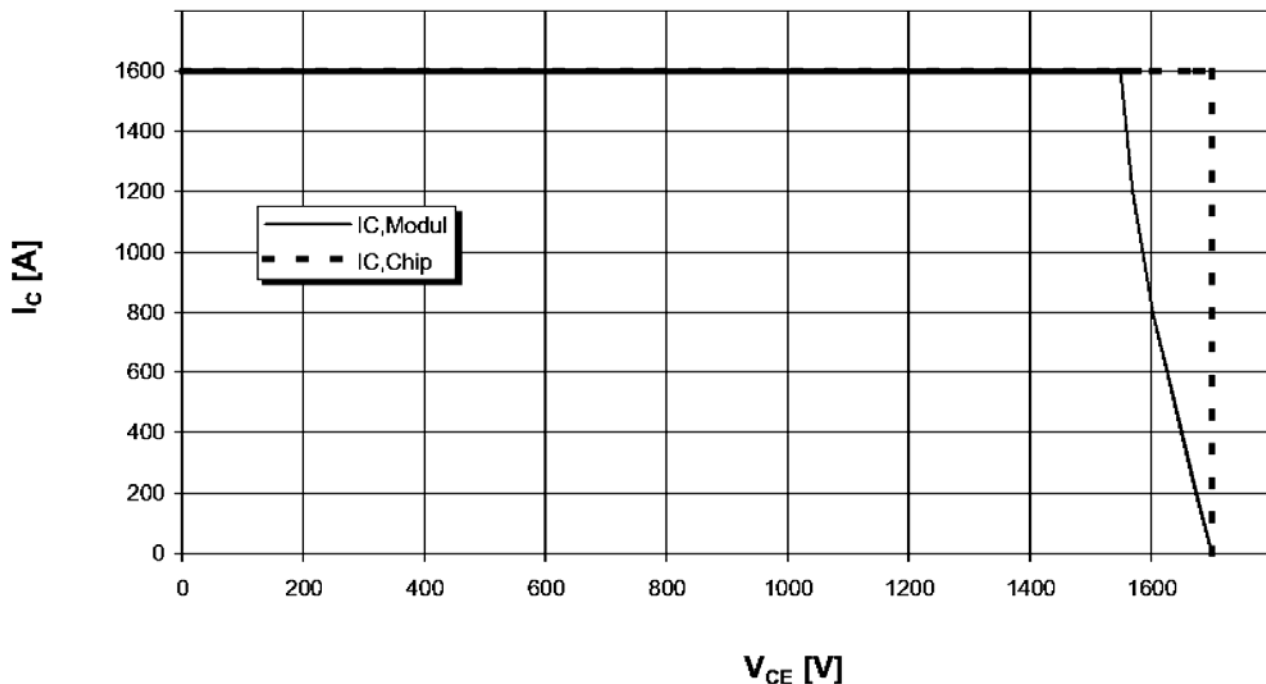
$$Z_{thjc} = f(t_p)$$



Обратная область безопасной работы

$$I_{C\ puls} = f(V_{CE})$$

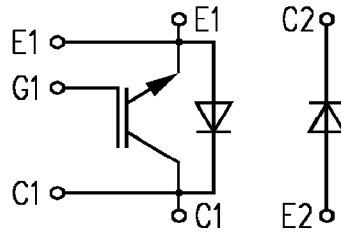
Режим измерения:  $R_G = 1.8\ \text{Ом}$ ,  $T_j = 125\ \text{°C}$



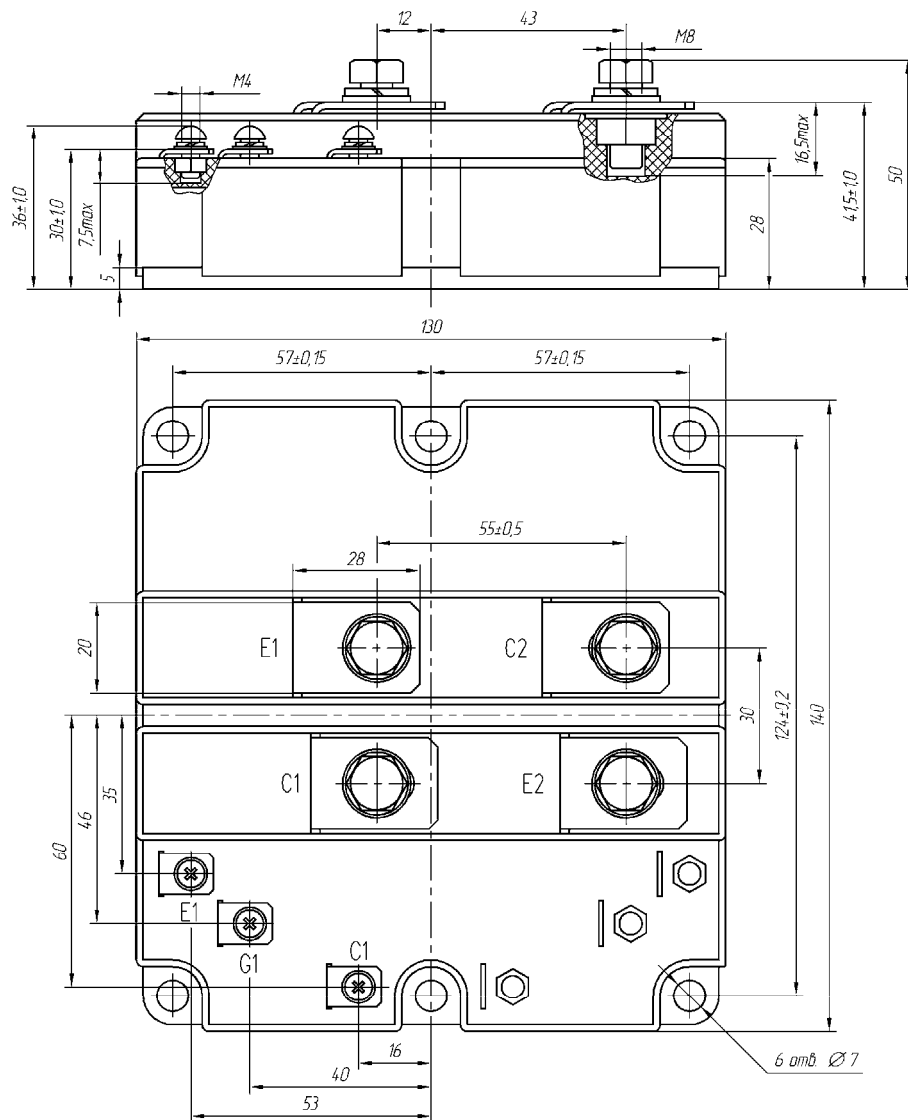


# МДТКИ-800-17Т

## СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ



## ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ



Масса 1.1 кг